

FIB-SEM-Ar/Xe トリプルビーム装置 NX2000

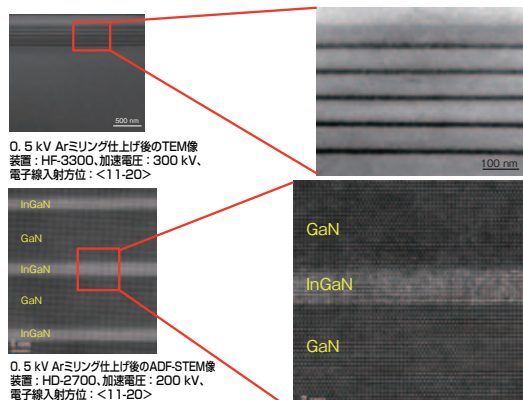
リアルタイム3Dアナリティカル FIB-SEM複合装置 NX9000

Triple Beam System FIB-SEM

Real-time 3D analytical FIB-SEM



トリプルビーム®装置を用いたGaN系化合物半導体のTEM試料作製



試料ご提供：名城大学理工学部 上山智先生

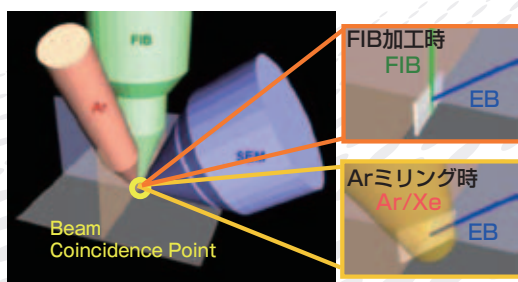
特長

- Ar/XeビームシステムがFIB加工のダメージ除去。
- 姿勢制御技術がカーテン効果の抑制やより均一な厚さの薄膜作製に寄与。
- 高コントラスト・高分解能リアルタイムSEMにより、正確な加工終点検知が可能。
＜20 nmの最先端デバイスの超薄膜作製に対応。
- Ar/Xe ion beam 3rd column for Ga FIB-induced damage reduction.
- High precision positioning mechanism enables sample orientation control for Anti-Curtaining Effects and uniformly-thick lamellas.
- High contrast and High resolution Real-time SEM enable accurate End-point detection. The system supports high quality TEM sample preparation for cutting edge applications.

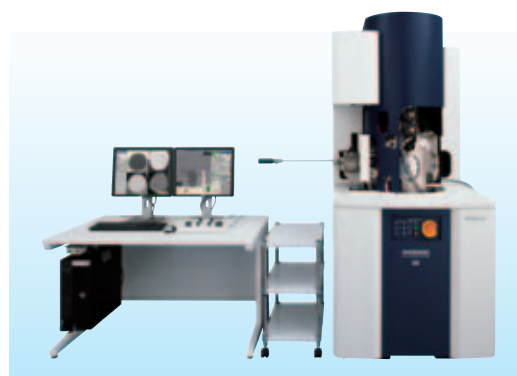
トリプルビーム®

= Ga-FIB + FE-SEM + Ar/Xe Beam
低加速FIB(0.5 kV~)

低加速Ar/Xe (0.5 kV~)

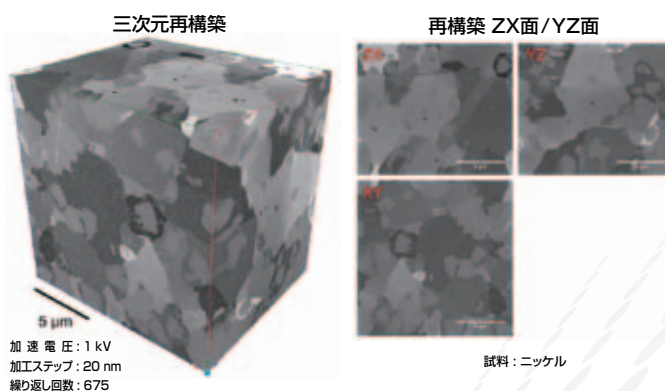


トリプルビーム®の模式図



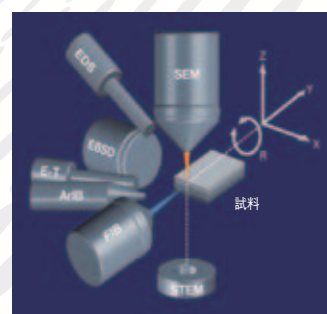
Science for
a better tomorrow

磁性材料の3次元構造解析

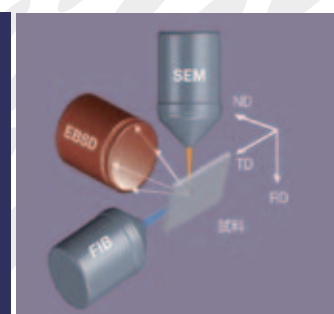


特長

- 高精度イオンビーム光学系により、最少1 nmのスライス加工が可能。
- FIBとSEMを垂直に配置することにより、試料構造を忠実に観察することが可能。
- EBSD直行配置により、3次元結晶方位解析の精度・スループットを大幅に向上。
- High precision ion beam optical system enables slicing of 1 nm minimum.
- Orthogonal column layout is optimized for 3D structural analysis.
- Ideal layout obtains accuracy and throughput of 3D crystal orientation analysis.



標準の試料位置 (SEM/STEM/EDS用)



EBSD用試料位置